

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-302816

(43)Date of publication of application : 28.10.1994

(51)Int.Cl.

H01L 29/784

(21)Application number : 05-090218

(71)Applicant : KAWASAKI STEEL CORP

(22)Date of filing : 16.04.1993

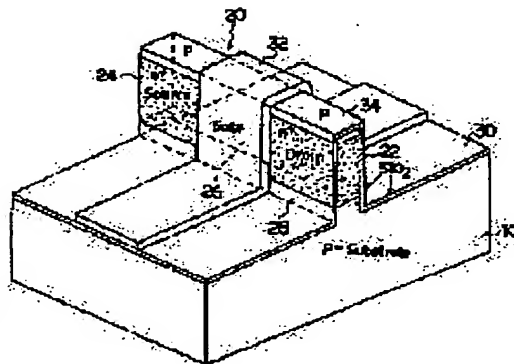
(72)Inventor : TADA YOSHIHIDE

## (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the upper-end part of a channel from being set to an ON state by a gate voltage which is lower than that of other parts in the channel and to obtain the good switching characteristic of a transistor by a method wherein a layer whose conductivity is the same as that of a channel region is formed at the upper-end part of a source region and of a drain region.

CONSTITUTION: An element region 20 is formed on a semiconductor substrate 10 so as to protrude, a source region 24 and a drain region 22 are formed there, a channel region 26 is formed between the source region 24 and the drain region 22, and a gate electrode 32 used to apply an electric field is formed in the channel region 26 via an insulator film 30. In a semiconductor device provided with such a field-effect transistor, a layer 34 whose conductivity is different from that of the individual regions 24, 22 and whose conductivity is the same as that of the channel region 26 is provided at the upper-end part of the source region 24 and of the drain region 22. Thereby, a channel part at the upper-end part of an Si protrusion part does not act as a channel, and the influence of a gate voltage at its upper part is weakened.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 14.04.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 08.01.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

2000

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-302816

(43)公開日 平成 6 年(1994)10月28日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

H 0 1 L 29/784

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

9054-4M

H 0 1 L 29/ 78

3 0 1 H

9054-4M

3 0 1 V

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平5-90218

(22)出願日 平成 5 年(1993) 4 月16日

(71)出願人 000001258

川崎製鉄株式会社

兵庫県神戸市中央区北本町通 1 丁目 1 番28  
号

(72)発明者 多田 ▲吉▼秀

千葉県千葉市中央区川崎町 1 番地 川崎製  
鉄株式会社技術研究本部内

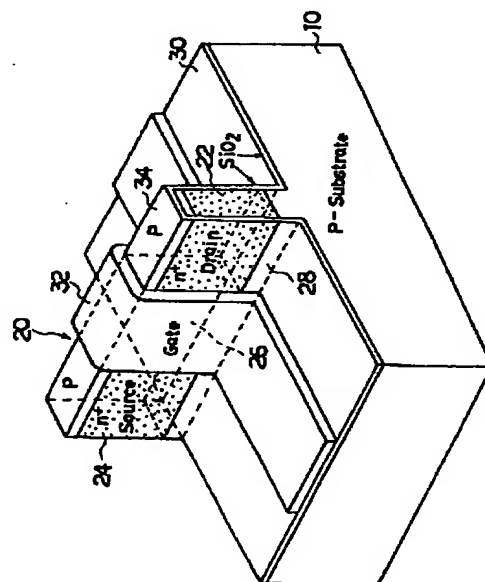
(74)代理人 弁理士 吉田 研二 (外 2 名)

(54)【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【目的】 縦型超薄膜トランジスタとした際に、上端部のチャンネル部の電界強度を改善し、良好なトランジスタのスイッチング特性が得られる半導体装置を提供する。

【構成】 基板 10 の上部には突出部 20 が形成されており、この突出部 20 の両側には、ドレイン領域 22、ソース領域 24 が形成されて、このドレイン領域 22、ソース領域 24 に挟まれた領域にチャンネル領域 26 が形成されている。また、基板 10 および突出部 20 の表面はすべて SiO<sub>2</sub> で形成される酸化膜 30 によって覆われており、チャンネル領域 26 の表面にはゲート電極 32 が形成されている。更に、突出部 20 の n<sup>+</sup> 型ドレイン領域 22、n<sup>+</sup> 型のソース領域 24 上端部は p 型の導電層 34 を有している。このため、チャンネル領域 26 の上端部とドレイン領域 22 及びソース領域 24 上端部とは同導電性となり、従って、Si 突出部 20 上端部のチャンネル部はチャンネルとして動作せず、チャンネル上端部がチャンネルその他の部分より低いゲート電圧でオンセットすることを防ぐことができる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板上に素子領域を突出形成し、ここにソース領域と、ドレイン領域と、該ソース領域及びドレイン領域間にチャンネル領域と、を設け、そのチャンネル領域に絶縁体膜を介して電界を印加するゲート電極を設けた電界トランジスタを有する半導体装置であって、

前記ソース領域及びドレイン領域の上端部は、その各々の領域の導電性とは異なり、前記チャンネル領域と同一の導電性からなる層を有することを特徴とする半導体装置。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、半導体基板上にMOSトランジスタなどの素子を形成する半導体装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より、各種の半導体装置が提案されており、特にMOSトランジスタを内蔵したものが多く利用されている。そして、このような半導体装置においては、その集積度を上昇させるために素子構造の微細化が進んでいる。

【0003】ここで、通常の半導体装置は、平板状の半導体基板（例えば、Si基板）の所定の領域に複数のMOSトランジスタ形成している場合が多い。この場合には、ゲート領域を薄い絶縁層を介しゲート電極で覆った状態でその両側の領域にイオンをドーピングして、ソース領域、ドレイン領域を形成しMOSトランジスタを半導体基板の所定領域に形成している。そして、このような半導体装置のMOSトランジスタを微細化していくと、各種の問題が生じる。すなわち、ドレイン付近の電界増加に伴いドレイン空乏層がソース近傍の電位障壁近くまで伸びパンチスルー電流が発生するなどの短チャンネル効果が発生したり、チャンネル内における電界強度の増加に伴いキャリアのエネルギーが増加し衝突電離により電子正孔対が発生するホットキャリア効果が発生したり、さらにチャンネルの垂直方向の電界が大きくなりキャリアの移動度が小さくなったり、隣接する素子との素子分離が十分行えなくなる等の問題が発生する。従って、従来の半導体装置では、そのゲート長をサブミクロン程度以下とすると、十分な性能、信頼性を保持できないという問題点があった。

【0004】一方、これらの問題点を改善するものとして、SOI（Silicon On Insulator）超薄膜トランジスタが提案されている。このSOI超薄膜トランジスタは、半導体基板上に酸化絶縁膜を形成し、この酸化絶縁膜上にソース、ゲート、ドレイン領域を形成したものである。この超薄膜トランジスタによれば、絶縁膜上にトランジスタを形成するため、短チャンネル効果、ホットキャリア効果の発生を抑制できると共

に、チャンネル全体に電圧を印加できるため垂直方向の電界を小さくしてキャリア移動度を大きく維持でき、さらに素子分離性に優れているという効果が得られる。

【0005】しかし、この超薄膜トランジスタはその構造上、絶縁膜上にトランジスタを形成するためのSi基板を形成することが必要である。ところが、絶縁膜（例えば、SiO<sub>2</sub>）にSi単結晶層を形成することは技術的に非常に難しい。特に、良質なSiエピタキシャル膜を形成することは現在のところ不可能であり、好適な性能を持つ超薄膜トランジスタを製造することは困難であった。

【0006】そこで、本願発明者らは、超薄膜トランジスタに類似の効果をえられる半導体装置として、Si基板上に突出部を設け、この突出部内にソース、チャンネル、ドレイン領域を設ける縦型超薄膜トランジスタを特願平4-17176号で提案している。すなわち、この縦型超薄膜トランジスタは、Si基板上に突起部を異方性エッチングによって形成している。そして、絶縁体膜（いわゆる、ゲート酸化膜）を介し配置されたゲート電極が、この突起部の中央部分にカバーしており、ゲート電極の内側をチャンネル領域とし、その両側がドレイン領域、ソース領域とされている。そして、ゲート電極の電位を変更することにより、チャンネル領域の状態を変化させ、ソース及びドレイン領域間の導通を制御できる。一方、ドレイン領域、ソース領域及びチャンネル領域の下方に、基板の組成がそのまま残る素子分離部を形成している。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の縦型超薄膜トランジスタにおいて、チャンネル領域の上端部は、その上方のゲート電圧のみならず、Si突出部の側壁のゲート電圧の影響も受けるため、電界が密になっている。従って、Si突出部上端部のチャンネル部は、Si突出部側壁のチャンネル部よりも低いゲート電圧でオンセットしてしまい、トランジスタのスイッチング特性が悪化するという問題点があった。

【0008】本発明は、上記問題点を解決することを課題としてなされたものであり、縦型超薄膜トランジスタとした際に、チャンネルの上端部がチャンネルのその他の部分より低いゲート電圧でオンセットすることを防ぎ、良好なトランジスタのスイッチング特性がえられる半導体装置を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明に係る半導体装置は、半導体基板上に素子領域を突出形成し、ここにソース領域と、ドレイン領域と、該ソース領域及びドレイン領域間にチャンネル領域とを設け、そのチャンネル領域に絶縁体膜を介して電界を印加するゲート電極を設けた電界トランジスタを有する半導体装置であって、前記ソース領域及びドレイン領域の上端部は、その各々の領域の導

電性とは異なり、前記チャネル領域と同一の導電性からなる層を有することを特徴とする。

【0010】

【作用】本発明に係る半導体装置において、ソース領域及びドレイン領域の上端部に、その各々の領域の導電性とは異なり、かつチャネル領域と同一の導電性からなる層を形成したので、チャネル領域の上端部とソース・ドレイン領域上端部とは同導電性となる。このため、Si突出部上端部のチャネル部はチャネルとして動作せず、その上方のゲート電圧の影響を弱められる。

【0011】

【実施例】以下、本発明に係る半導体装置について、図面に基づいて説明する。

【0012】図1は、上述のようにして製造された半導体装置の構成を説明するための斜視図である。

【0013】p型のSi基板10の上部には、突出部20が形成されている。そして、この突出部20の両側には、n<sup>+</sup>型のドレイン領域22、n<sup>+</sup>型のソース領域24が形成されており、このドレイン領域22、ソース領域24に挟まれた領域に基板10と同じp型のチャネル領域26が形成されている。そして、これらドレイン領域22、ソース領域24、チャネル領域26はその下端が突出部20内に収まっており、突出部20の下部には基板10の一部である素子分離部28が形成されている。

【0014】また、基板10および突出部20の表面はすべてSiO<sub>2</sub>で形成される酸化膜30によって覆われており、チャネル領域26の表面にはゲート電極32が形成されている。このため、この酸化膜30はゲート酸化膜として機能する。また、ゲート電極32は、外部との電気的接続のため、基板10の所定の端部まで引き回されている。

【0015】更に、突出部20のn<sup>+</sup>型ドレイン領域22、n<sup>+</sup>型のソース領域24上端部はp型の導電層34が形成されている。このため、チャネル領域26の上端部とソース・ドレイン領域上端部とは同導電性となり、従って、Si突出部20上端部のチャネル部はチャネルとして動作せず、その上方のゲート電圧の影響を弱められる。

【0016】このような半導体装置では、突出部20内に1つのMOSトランジスタが構成されている。従って、ドレイン領域22、ソース領域24にそれぞれドレイン電極、ソース電極を接続すれば、ゲート電極32への電圧の印加によって、チャネル領域26の電位を制御しドレイン領域22→ソース領域24間の電流を制御することができる。この例では、形成されているMOSトランジスタがnチャネルであるため、ゲート電極に正の電圧を印加することによって、電流が流れる。

【0017】特に、本実施例の装置によれば、突出部20の上端部で酸化膜30の下方に、所定の膜厚の酸化膜

12が設けられている。従ってこのゲート酸化膜は、この部分の膜厚が側壁膜厚より厚くなっている、このため、チャネル領域26の上端部のチャネル部において、その上端部のゲート電圧の影響が弱められ、このチャネル部の閾値電圧が従来より高くなって、他の部分に先駆けてオンセットされることを重ねて防ぐ効果がある。

【0018】一方、前述の素子分離部28は基板10の一部である。そこで、衝突電離によって発生する基板と同極性の余剰キャリア（本例の場合、正孔）が基板10に排出されることになり、チャネル領域26に溜まることがない。従って、SOIに見られるような余剰キャリアの蓄積に伴うキンク（Kink）現象の発生がなく、また余剰の正孔による疑似短チャネル効果の発生がない。また、消費電力により発生した熱が基板10に容易に拡散するため、チャネル領域26の加熱を防止することができる。

【0019】さらに、トランジスタを縦型とし、チャネル領域26をゲート電極32によって取り囲んでいるため、チャネル領域全体の電圧を所定の値に制御することができ、動作性能を非常に高いものとすることができる。

【0020】また、本発明に係る半導体装置の製造方法について、図面に基づいて説明する。

【0021】本実施例の半導体装置の製造方法について、図2及び図3に基づいて説明する。まず、第一の実施例は図2に示されるように、Si単結晶からなる基板10表面上に、SiO<sub>2</sub>膜（またはSiN膜）による線幅0.1μm程度の線状パターンを形成する（S1）。この線状パターンの形成は、電子（EB）ビーム描画露光装置および多層レジスト露光技術などを利用した超微細パターンニング技術によって行う。そして、このSiO<sub>2</sub>（またはSiN）線状パターンをマスクとして、RIE（Reactive Ion Etching）などによって基板10に異方性エッチングを施し、所定の凹部40を形成して突出部20を形成する（S2）。次に、このマスクとして機能したSiO<sub>2</sub>パターン12を除去することなく、基板10の全表面を熱酸化しSiO<sub>2</sub>酸化膜30を形成する（S3）。そして、全表面にポリシリコン層Poly-Siを形成した（S4）後、通常のフォトリソグラフィにより、ゲート電極32を形成する（S5）。その後、イオン注入によりドレイン領域22、ソース領域24を形成する（本実施例では、例えばリンの注入によるn<sup>+</sup>領域の形成）。ここで、このイオン注入は、不純物の照射方向をマスク、電圧印加などによって斜め方向のみに限定する斜入射イオン注入装置によって行う（S6）。

【0022】従って、ドレイン領域22、ソース領域24の上端部には厚めのSiO<sub>2</sub>酸化膜30が形成されているので、斜めイオン注入をする際に、この上端部の近傍部は他の部分に比べn<sup>+</sup>型の不純物が注入されにく

い。このため、p型のままだしくはn<sup>-</sup>型の導電層34として残留し、チャンネル領域26の上端部とソース領域26・ドレイン領域24上端部とは同導電性となり、Si突出部上端部のチャンネル部はチャンネルとして動作せず、その上方のゲート電圧の影響を弱められる。これによって、Si突出部20の上端部のチャンネル部において、その上方のゲート電圧の影響が弱められたので、この部分の閾値電圧が従来より高くなり、他の部分に先駆けてオンセットされることがない。

【0023】このイオン注入の後、ソース及びドレイン領域の酸化膜を除去したのち、必要に応じてアニール処理を行って各領域の結晶構造等を調整する。

【0024】次に、第二の実施例を図3にて説明する。

【0025】基板10表面上に、SiO<sub>2</sub>膜（またはSiN膜）による線状パターンを形成し、このSiO<sub>2</sub>（またはSiN）線状パターンをマスクとして、RIEなどによって基板10に異方性エッチングを施し、所定の凹部40を形成して突出部20を形成する（S1～S2）。次に、このマスクとして機能したSiO<sub>2</sub>パターン12を除去し、基板10の全表面を熱酸化しSiO<sub>2</sub>酸化膜30を形成する（S3）。そして、全表面にポリシリコン層Poly-Siを形成した（S4）後、通常のフォトリソグラフィにより、ゲート電極32を形成する（S5）。その後、イオン注入によりドレイン領域22、ソース領域24を形成する（本実施例では、例えばリンの注入によるn<sup>+</sup>領域の形成）。ここで、このイオン注入は、不純物の照射方向をマスク、電圧印加などによって斜め方向のみに限定する斜入射イオン注入装置によって行う（S6）。その後、ドレイン領域22、ソース領域24の上端部にその上方から前述の不純物とは導電性の異なる不純物（本実施例ではp<sup>+</sup>型の不純物、例えばボロン）を垂直にイオン注入する（S7）。

【0026】従って、ドレイン領域22、ソース領域24の上端部は先のイオン注入によってn<sup>+</sup>型となったとしても、後にp<sup>+</sup>型の不純物が注入されるのでp型の導電層34となる。このため、第一の実施例と同様に、チャンネル領域26の上端部とソース領域26・ドレイン領域24上端部とは同導電性となり、Si突出部20上端部のチャンネル部はチャンネルとして動作せず、その上方のゲート電圧の影響を弱められ、その部分の閾値電圧が従来より高くなり、他の部分に先駆けてオンセットされることがない。

【0027】更に、斜イオン注入ののち、両領域に注入された不純物と導電性の異なる不純物を垂直に注入するので、斜めイオン注入の際に、不純物が突出部20の側面によって一部反射され、突出部20間に存在する基板表面付近に注入されたとしても、電荷を中和することができる。従って、この基板表面付近にはチャンネルとなら

ない。

【0028】なお、この垂直イオン注入は、この段階ではなく、先の凹部40形成後、Poly-Si生面形成の前に行ってもよい。

【0029】このイオン注入の後、ソース及びドレイン領域の酸化膜を除去したのち、必要に応じてアニール処理を行って各領域の結晶構造等を調整する。

【0030】

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る半導体装置によれば、ソース領域及びドレイン領域の上端部に、その各々の領域の導電性とは異なり、かつチャンネル領域と同一の導電性からなる層を形成したので、チャンネル領域の上端部とソース・ドレイン領域上端部とは同導電性となる。このため、Si突出部上端部のチャンネル部はチャンネルとして動作せず、その上方のゲート電圧の影響を弱められる。

【0031】また、Si突出部の上端部のチャンネル部において、その上方のゲート電圧の影響が弱められたので、Si突出部上端のチャンネル部の閾値電圧が従来より高くなり、この部分が他の部分に先駆けてオンセットされることがない。

【0032】更に、ソース・ドレイン領域形成のための斜イオン注入ののち、両領域に注入された不純物と導電性の異なる不純物を垂直に注入するので、斜めイオン注入の際に、不純物が突出部の側面によって一部反射され、突出部間に存在する基板表面付近に注入され、この部分の不純物濃度が薄くなるか、もしくは基板と逆の極性となったとしても、これを打ち消し、この部分の基板不純物濃度を高くすることができる。従って、この基板表面付近はチャンネルとはならない。

【図面の簡単な説明】

【図1】半導体装置の構成を示す斜視図である。

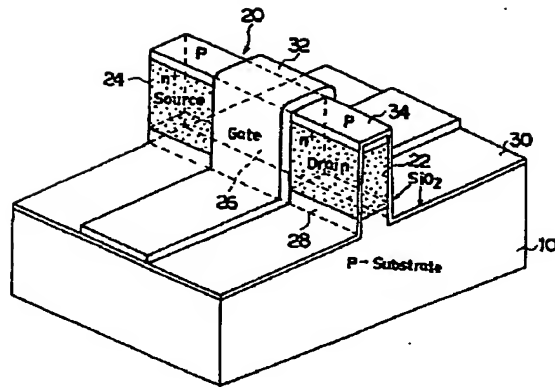
【図2】半導体装置の製造工程の第一の実施例の説明図である。

【図3】半導体装置の製造工程の第二の実施例の説明図である。

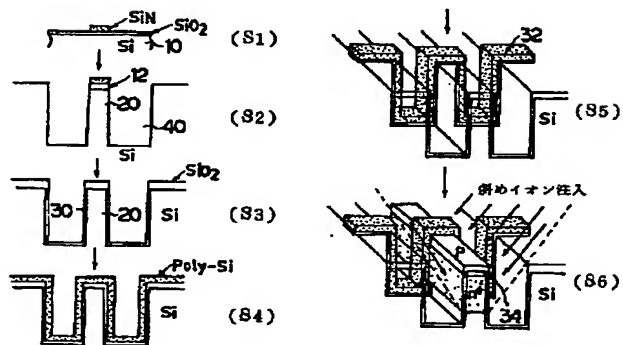
【符号の説明】

- 10 基板
- 12 線状パターン用酸化膜
- 20 突出部
- 22 ドレイン領域
- 24 ソース領域
- 26 チャンネル領域
- 30 酸化膜
- 32 ゲート電極
- 34 p型導電層
- 40 凹部

【図1】



【図2】



(6)

特開平6-302816

【図3】

